

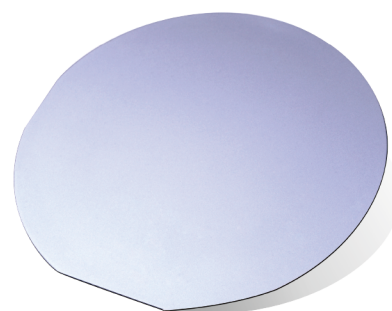
磷化铟衬底晶片

磷化铟（InP）作为一种性能优异的半导体材料，具有电子迁移率高、耐辐射性能好、禁带宽度大等优点。主要应用于通讯及微电子领域，包括光纤通讯、无线网络、手机、蓝牙通讯、卫星通讯、卫星通讯微波领域，以及射频集成电路等。

先导可提供使用2-4英寸的InP衬底，包括半绝缘InP衬底（掺Fe）和半导体InP衬底（掺Si或掺Zn），以及用于特定用途的低位错InP衬底。亦可根据客户需求，定制非标厚度和晶向的InP衬底。

单位		半绝缘 规格	半导体 规格		
导电类型		-	n型	n型	p型
晶体生长方式		VGF	VGF		
掺杂		Fe	S, Sn	无掺杂	Zn
尺寸	inch	2", 3", 4"	2", 3", 4"		
晶向*		(100) ± 0.5°	(100) ± 0.5°		
OF/IF		US, EJ	US, EJ		
载流子浓度	cm ⁻³	-	(0.8-8) × 10 ¹⁸	(1-10) × 10 ¹⁵	(0.8-8) × 10 ¹⁸
电阻率（室温）	cm ⁻³	≥ 0.5 × 10 ⁷	-	-	-
电子迁移率	cm ² /v. s	≥ 1000	1000-2500	3000-5000	50-100
位错密度（EPD）	/cm ²	≤ 5000	≤ 5000	≤ 5000	≤ 500
激光打标		按客户要求定制	按客户要求定制		
成品厚度*	μ m	(350-675) ± 25	(350-675) ± 25		
TTV平整度（双抛）	μ m	≤ 10	≤ 10		
TTV平整度（单抛）	μ m	≤ 15	≤ 15		
翘曲度	μ m	≤ 15	≤ 15		
主面/背面	Side1	抛光	抛光		
	Side2	抛光/腐蚀	抛光/腐蚀		
开盒即用		是	是		
包装		单片盒或多片盒	单片盒或多片盒		

*晶向、厚度可按客户要求定制



广东先导微电子科技有限公司

高纯材料生产基地：广东省清远市高新区创兴三路16号

电话：0763-3993123 传真：(86) 020 - 83511907

邮箱：semi_sales@vitalchem.com

邮编：511517

网站：www.vitalchem.com